

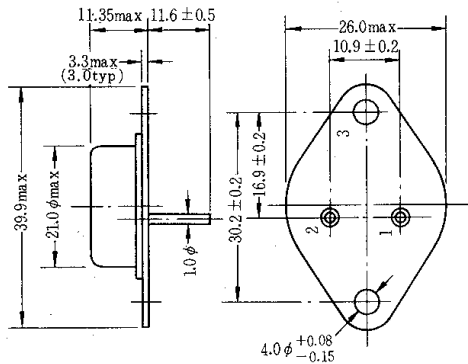
2SB612, 2SB612A

シリコン PNP エピタキシャル形

80~100W オーディオアンプ出力用
2SD582, 582A とコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL

80~100W AUDIO AMP. AUDIO OUTPUT
Complementary pair with 2SD582/A



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

アクセサリ Accessories

スパーサ Spacer	SK40C
ワッシャ Washer	YD40D

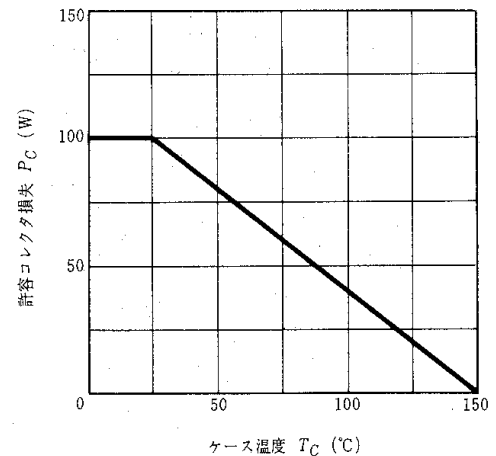
■最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SB612	2SB612A	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	-180	-180	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	-140	-160	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	-6	-6	V
コレクタ電流		I_C	-12	-12	A
せん頭コレクタ電流		$i_{C(\text{peak})}$	-15	-15	A
ベース電流		I_B	-2	-2	A
許容コレクタ損失		P_C^*	100	100	W
接合部温度		T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-55~+150	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	2SB612		2SB612A		Unit
				min	max	min	max	
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-140	—	-160	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-5\text{mA}, I_C=0$	-6	—	-6	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=-160\text{V}, I_E=0$	—	-10	—	-10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*		$V_{CE}=-5\text{V}$	$I_C=-1\text{A}$	35	200	35	200
	h_{FE2}			$I_C=-7\text{A}$	20	—	20	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=-7\text{A}, I_B=-0.7\text{A}$	—	-1.5	—	-1.5	V
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$	—	-1.5	—	-1.5	V
安全動作領域		ASO	$V_{CB}=-90\text{V}, t=1\text{sec}$	-1	—	-1	—	A
2次破壊電流		I_M	$V_{CE}=-90\text{V}, 50\text{Hz Half Wave}, 30\text{ Pulses}$	-3	—	-3	—	A

* 2SB612, 612A は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

* The 2SB612/A is grouped by h_{FE1} as follows.

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
35~70	60~120	100~200